مکانیک سازهها و شارهها/ سال ۱۳۹۴/ دوره ۵/ شماره ۳/ صفحه ۲۷۱–۲۸۷

مجله علمى تروبهش مكانيك سازه باو شاره با



شبیهسازی عددی دینامیکی و ترمودینامیکی یک ریزپمپ ام اچ دی با تغییر مستقل طولهای دو میدان الکتریکی و مغناطیسی

مر تضی دلاکه نژاد^ا، سیّد علی میربزر گی^{۲.*} ^۱ دانشجوی دکتری، مهندسی مکانیک، دانشگاه بیرجند، بیرجند ^۲ دانشیار، مهندسی مکانیک، دانشگاه بیرجند، بیرجند تاریخ دریافت: ۱۳۹۲/۱۲/۰۶؛ تاریخ بازنگری: ۱۳۹۴/۰۸/۱۷

چکیدہ

در این مقاله، اثر تغییرات مستقل طول میدانهای الکتریکی و مغناطیسی با لحاظ نواحی نفوذ جانبی بر توزیع دما و سرعت جریان در یک ریزپمپ دیناموهیدرومغناطیسی شبیهسازی شده است. هندسه جریان ام اچ دی، یک مجرای دو بعدی بین دو صفجه موازی است و معادلات حاکم بر دو میدان جریان سیال و الکترومغناطیس به روش عددی حجم محدود حل شده است. نتایج عددی نشان داد که با لحاظ تابعیت دمایی خواص برای جریان در یک مجرا به مقطع مستطیلی ۱۰۰۰ میلیمتر مربع، شدت شار مغناطیسی ۲۰۱۵ تسلا و قدرت میدان الکتریکی ۲۰ ولت بر میلیمتر، دبی عبوری جریان در صورت تغییر طول مستقل دو میدان الکتریکی و مغناطیسی حداکثر به مالی تر میلی الیتر بر ثانیه می سد. این در حالی است که در حالت تغییر طول مستقل میدان مغناطیسی، دمای میانگین کاسه ای از ۲۵ درجه سانتی گراد ورودی به ۴۵ درجه سانتی گراد خروجی می سد و در حالت تغییر طول مستقل میدان الکتریکی، دمای خروجی به ۳۵ درجه سانتی گراد می سد. در وضعیت ثابت بودن خواص، حداکثر دبی به ۲۰ میلیلیتر بر ثانیه می سد؛ درحالی که دمای میانگین کاسه ای برای حالت تغییر طول مستقل میدان الکتریکی، به ۲۰ درجه سانتی گراد و برای حالت تغییر طول مستقل میدان الکتریکی، دمای خروجی به ۵۵ درجه سانتی گراد می سد. در وضعیت ثابت بودن خواص، حداکثر دبی به ۲۰ میلیلیتر بر ثانیه می سد؛ درحالی که دمای میانگین کاسه ای برای حالت تغییر طول مستقل میدان مغناطیسی، به ۱۴۰ درجه سانتی گراد و برای حالت تغییر طول مستقل میدان الکتریکی، دمای میانگین کاسه ای برای سانتی گراد می رسد.

کلمات کلیدی: ریزپمپ ام اچ دی؛ نیروی لورنتز؛ جریان کاملاً توسعه یافته؛ طول میدان الکتریکی؛ طول میدان مغناطیسی.

Numerical Simulation of Dynamic and Thermodynamic an MHD Micro-pump by Changing Electric and Magnetic Field Lengths Independently

M. Dallakehnezhad¹, S.A. Mirbozorgi^{2,*} ¹ Ph.D. Student, Mech. Eng., Birjand Univ., Birjand, Iran. ² Associate. Prof., Mech. Eng., Birjand Univ., Birjand, Iran.

Abstract

In this work, the effect of independent electric and magnetic field length changes on the temperature distribution and flow velocity of a magneto-hydrodynamic micro-pump is simulated considering the lateral electromagnetic diffusive regions. The geometry of an MHD flow is a 2D channel between two parallel plates, and the governing equations of both flow and electromagnetic fields are solved using the finite volume numerical method. The numerical results show that by applying the temperature allegiance of fluid properties, for a flow in a channel of 1000 mm² cross-section, a magnetic field intensity of 0.025 Tesla, and an electric field strength of 20 volt/mm, the flow rate reaches 250 mL/s when the electric and magnetic field lengths are changed. However, in the case of an independent change in the magnetic field length, the mean cup temperature from 25 $^{\circ}$ C at entrance reaches 45 $^{\circ}$ C at exit, and in the case of an independent change in the electric field, the exit temperature reaches 35 $^{\circ}$ C. In the situation of constant properties, the maximum flow rate reaches 70 mL/s, while the mean cup temperature reaches 140 $^{\circ}$ C for the case of an independent change in the electric field length.

Keywords: MHD Micro-pump; Lorentz Force; Fully-Developed Flow; Electrode Field Length; Magnetic Field Length.

* نویسنده مسئول؛ تلفن: ۹۸۹۱۵۳۶۳۶۷۶۹+ ؛ فکس: ۰۵۶۳۲۲۰۲۱۳۳

آدرس پست الكترونيك: samirbozorgi@birjand.ac.ir

۱– مقدمه

ریزپمپها^۱ یکی از قسمتهای مهم در سیستمهای ریزالکترومکانیکی زیستی^۲ و سیستمهای ریزسیالی^۳ هستند که کاربرد آنها در سه دهه گذشته گسترش قابل توجهی پیدا مرکده است. این ریزپمپهای مکانیکی و غیرمکانیکی [۱]. در میشوند: ریزپمپهای مکانیکی و غیرمکانیکی [۱]. در حرکت سیال استفاده میشود. تحریک این غشاء به وسیله مکانیزمهای مختلفی از جمله: الکترواستاتیک^۴، پیزوالکتریک^۵ و الکترومغناطیس^۶ انجام میشود [۲]. یکی از مزیتهای اصلی این ریزپمپها، قابلیت اعتماد به سیستم و عدم وابستگی مکانیزم تولید فشار در آنها به سیالهای خاص است. تحریک غشاء، یکی از معایب این ریزپمپها است [۳]. بعلاوه جریان ایجاد شده در این نوع ریزپمپها پیوسته نبوده، اغلب متناوب است.

از سوی دیگر، ریزپمپهای غیرمکانیکی فاقد اجزای متحرک بوده، مشکلات فرسایش و خستگی قطعات را ندارند. این ریزپمپها به وسیله مکانیزمهای مختلفی بسته به کاربردشان عمل میکنند. برای مثال، میتوان به مکانیزمهای الکترواسموزی (ای او)^۷ [۴]، الکتروهیدرودینامیک (ای اچ دی)^۸ [۵] و دیناموهیدرومغناطیسی (ام اچ دی)^۴ [۶] اشاره کرد. از طرف دیگر، هدایت الکتریکی سیال در ریزپمپهای الکترواسموزی و الکتروهیدرودینامیکی در محدوده ^{۱۵}-۱۰ تا ریزیمنس بر متر است. در حالی که در ریزپمپهای دیناموهیدرومغناطیسی مقدار هدایت الکتریکی سیال در سیالاتی با هدایت الکتریکی در محدوده ^{۲۰}-۱۰ و ۱ زیمنس بر متر، میتواند توسط هر سه مکانیزم مورد اشاره پمپ شود [۷]. ریزپمپهای دیناموهیدرومغناطیسی (ام اچ دی)، اخیراً

توجه محققان در حوزه ریزسیالی را نیز به خود جلب کرده است. این ریزپمپها برای کاربردهای زیستی مناسب می-باشند. عامل تحریک جریان در این نوع از ریزپمپها، نیروی لورنتز حاصل از اعمال دو میدان الکتریکی و مغناطیسی متعامد است.

یدیده ام اچ دی ابتدا توسط ریچه [۸]، مشاهده شد. در سال ۱۹۴۰ آلفن [۹]، اصول کلی این پدیده را فرمول بندی کرد و بواسطه آن در سال ۱۹۷۰ جایزه نوبل را دریافت کرد. جانگ و لی [۱۰]، از اولین کسانی بودند که در زمینه ریزپمپهای ام اچ دی با جریان مستقیم مطالعاتی را به طور تجربي انجام دادند. وينوويچ و همكارانش [11] و راموس و وينوويچ [۱۲]، هر دو روش اجزا محدود و اختلاف محدود را برای تحلیل جریان ام اچ دی و تعیین تاثیرات اعداد رینولدز و هارتمن بكار بردند. ليموف و همكارانش [١٣] و ليموف و لى [۱۴]، دو ريز پمپ ام اچ دى از نوع متناوب و مستقيم ساخته و مورد مطالعه قرار دادند. آنها مشاهده کردند که چنانچه میدانهای الکتریکی و مغناطیسی بکار رفته از نوع مستقيم باشد، پديده مخرب حبابزايي به علت الكتروليز شدن سیال درون کانال، بر اثر عبور جریان الکتریکی رخ می-دهد؛ اما با بکار بردن میدانهای متناوب مشاهده شد که این حبابزایی کمتر می شود. ژانگ و همکارانش [۱۵]، جریان ام اچ دی درون ریزمجرای ساخته شده از سرامیک را مطالعه کردند. جی ای هو [۱۶]، مشخصات یک ریزیمپ ام اچ دی در حوزه پزشکی را مطالعه کرد. او نشان داد، محدوده ولتاژ بین ۰ تا ۱۲ ولت و شدت شار مغناطیسی کمتر از ۰/۰۴ تسلا، برای عملکرد این ریز پمپها کاملاً مناسب است و حبابزایی داخل کانال کاهش می یابد. دوویری و عبدالله [۱۷، ۱۸ و ۱۹]، جریان آرام، گذرا، کاملاً توسعه یافته در ریزپمپهای دیناموهیدرومغناطیسی را مطالعه و توزیع دمای داخل ریزمجرای آن را گزارش کردند. آنها اثر پارامترهای مختلف نظیر، اعداد هارتمن، پرانتل، اکرت، استنتون و نسبت منظری مقطع ریزمجرا را بر افزایش دما و سرعت جریان مطالعه کردند. مطالعه آنها در دو حالت جریان متناوب و جریان مستقیم، به طور عددی و تحلیلی صورت گرفته است. ویب هو [۳]، اثرات حرارتی و الکترواسموزی جریان در ریزپمپ ام اچ دی را بررسی کرد. او نشان داد که مقاطع با هندسههای مختلف، تاثیر به سزایی روی دما و دبی جریان در

¹Micropumps

² Bio- MEMS (Bio-Micro Electro Mechanical System)

³ Microfluidics

⁴ Electrostatical ⁵ Pizoelectrical

⁶ Electromagnetical

⁷ Electroosmosis (EO)

⁸ Electrohydrodynamic (EHD)

⁹ Magnetohydrodynamic (MHD)

ریزمجرا دارد. بهرهمندی و میربزرگی [۲۰]، نشان دادند که برای یک نیروی حجمی یکنواخت در عرض مجرا، نظیر نیروی لورنتز در حضور طولهای عایق ورودی و خروجی، جریان در سراسر طول مجرا و حتی در محل اتصال طولهای عایق با الکترودها کاملاً توسعه یافته است.

در اغلب مقالات یاد شده، تغییرات پارامترهای مهم این جریان بررسی شده است و به عنوان مثال، اثر تغییرات اعداد بی بعد نظیر، هارتمن بین ۰ تا ۱۰، پرانتل بین ۱/۰ تا ۵، اکرت بین ۱/۰ تا ۵/۰، استن تون بین ۴ تا ۸ و نسبت منظری بین ۲/۰ تا ۱ مطالعه شده است. بعلاوه اثرات شدت شار مغناطیسی بین ۱۹/۰ تا ۴۴/۰ تسلا و ولتاژ اعمالی بین ۱۰ تا ۶۰ ولت نیز بررسی شده است. با وجود این، اثرات مشخصات حرارتی و دینامیکی جریان، کمتر بررسی شده است. به نظر می سد که تغییرات طول مستقل میدانهای عبوری از پمپ تاثیر قابل توجهی داشته باشد. در این مقاله، اثر تغییر طولهای مستقل دو میدان الکتریکی و مغناطیسی روی مشخصات حرارتی و دینامیکی جریان، کمتر بررسی شده میدانهای مستقل میدانهای الکتریکی و مغناطیسی و دبی و مغناطیسی روی طرح جریان، دمای سیال و دبی مقاله، اثر تغییر طولهای مستقل دو میدان الکتریکی و مغناطیسی و مغناطیسی و میدان الکتریکی و مغناطیسی

۲- فیزیک مسئله

در شکل ۱، طرح شماتیک یک ریزپمپ ام اچ دی نشان داده شده است که شامل یک ریزمجرای با مقطع مستطیلی ($h \times h$) برای عبور جریان سیال است. به منظور اجرای یک تحلیل دو بعدی برای جریان در صفحه xx، عرض h مجرا، بسیار کمتر از عمق d (واحد) در نظر گرفته شده است. همچنین به منظور اعمال نیروی الکترومغناطیسی بر سیال، به دلخواه روی دیوارههای جانبی مجرا در منطقه میانی، یک آهنربای دائمی با طول L_p و عرض ثابت h نصب شده است. الکترودهایی به طول L_e و عمق ثابت d برای اعمال میدان الکتریکی قرار داده شده است. دیوارههای ریزمجرا بجز در عبوری از مجرا به قدر کافی بزرگ باشد، میدان الکتریکی سیال بین دو الکترود، سبب برقراری یک جریان الکتریکی از درون سیال میشود. همانطور که مشاهده میشود، میدان

مغناطیسی اعمال شده توسط آهنربای دائمی عمود بر راستای میدان الکتریکی بین دو الکترود است. طبق تئوری الکترومغناطیس در این حالت، نیرویی در راستای عمود بر هر دو جهت میدانهای مغناطیسی و الکتریکی بر سیال اعمال میشود که این نیرو به نام نیروی حجمی لورنتز شناخته میشود.

نمای راست شکل ۱ را میتوان به صورت یک طرح شماتیک دو بعدی، در شکل ۲ نمایش داد که در آن عمق مجرا d عمود بر صفحه کاغذ است. با توجه به اینکه میدانهای الکتریکی و مغناطیسی همواره بر بخش میانی طول مجرا اعمال میشود، طولهای طرفین این دو میدان که با L و L مشخص شدهاند، طولهای عایق ورودی و خروجی نامیده میشوند. در پژوهش حاضر، همواره mm ا h = 1 و h = 1 mm بنابراین با توجه به نامیده میشوند. در پژوهش حاضر، همواره متغیر بودن L = 1 در پژوهش حاضر، همواره



سیال در راستای *x*



شکل ۲- طرح شماتیک دو بعدی از یک ریز پمپ ام اچ دی

۳- معادلات حاکم

معادلات دیناموهیدرومغناطیسی حاکم بر جریان تراکمناپذیر یک سیال نیوتنی با خواص ترموفیزیکی تابع دما در حالت دائم، بهترتیب شامل، پیوستگی، اندازه حرکت خطی، انرژی، قانون اهم، معادله حاکم بر میدان الکتریکی (() و معادله حاکم بر میدان القای مغناطیسی (B)است [11].

$$\nabla \cdot \vec{V} = 0 \tag{1}$$

که در آن $\vec{V} = u\vec{i} + v\vec{j}$ بردار سرعت جریان در حالت دو بعدی با واحد ($\frac{m}{s}$) است.

$$\rho\left(\vec{V}\cdot\nabla\right)\vec{V} = -\overrightarrow{\nabla P} + \mu\nabla^{2}\vec{V} + \vec{J}\times\vec{B}$$
^(Y)

که در آن $\vec{B} \times \vec{I}$ نیروی حجمی لورنتز با واحد ($\frac{N}{m^3}$)، \vec{J} بردار شدت جریان الکتریکی با واحد آمپر بر متر مربع، \vec{B} بردار شدت شار مغناطیسی با واحد ($\frac{Vs}{m^2}$)، ρ چگالی سیال با واحد ($\frac{Ns}{m^3}$)، P فشار با واحد ($\frac{N}{m^2}$) و μ لزجت دینامیکی سیال با واحد ($\frac{Ns}{m^2}$)، است.

$$\rho C_P \frac{DT}{Dt} = k \nabla^2 T + \frac{J^2}{\sigma} \tag{(7)}$$

که در آن C_P ظرفیت گرمایی سیال با واحد $(\frac{k_{B}}{k_{B}K})$ ، k هدایت حرارتی سیال با واحد $(\frac{W}{m K})$ ، T دما برحسب کلوین، σ هدایت الکتریکی سیال با واحد $(\frac{T}{n m})$ و $\frac{J^2}{\sigma}$ جمله مربوط به گرمایش ژول است که به علت عبور جریان الکتریکی از درون سیال بهوجود میآید.

$$\vec{I} = \sigma \left(-\nabla \varphi + \vec{V} \times \vec{B} \right) \tag{(f)}$$

که در آن
$$arphi$$
 میدان الکتریکی برحسب ولت است.

$$\nabla^2 \varphi = \nabla \cdot \left(\vec{V} \times \vec{B} \right) \tag{(\Delta)}$$

$$\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} = \nabla \times \left(\vec{V} \times \vec{B} \right) + \frac{1}{\sigma \mu_m} \nabla^2 \vec{B} \quad \& \quad \nabla \cdot \vec{B} = 0 \tag{(9)}$$

که در آن μ_m نفوذ پذیری مغناطیسی برحسب نیوتن بر مربع آمپر است. در مقیاسهای آزمایشگاهی (پایین بودن عدد هارتمن) جمله $(\vec{B} \times \vec{B}) \times \nabla$ در مقایسه با دو جمله دیگر معادله ناچیز بوده، قابل صرفنظر کردن است [۲۲]. از طرف دیگر، با توجه به اینکه در این پژوهش $0 = \delta \vec{B} / \partial t$ اتخاذ

شده است، معادله القاء مغناطیسی (۶) به صورت رابطه (۷) خلاصه میشود.

 $abla^2 B = 0 & \& \nabla \cdot \overrightarrow{B} = 0 \quad (Y)$ $B_y = 0 & \& \overrightarrow{B} = B_x \overrightarrow{i} + B_z \overrightarrow{k}$ (Y) $B_y = 0$ در کار حاضر، $\overrightarrow{B} = B_x \overrightarrow{i} + B_z \overrightarrow{k}$ است؛ یعنی مرا i است؛ زیرا تغییر طول میدان مغناطیسی در راستای جریان v i مورد نظر است و عرض میدان مغناطیسی در راستای مر v i همواره برابر عرض مجرا h است و در ناحیه عرضی مجرا $B_x = 0$ a_z ($B_z = 0$ model of x and x of x of

۳-۱- بیبعد سازی معادلات حاکم

متغیّرهای موجود در مسئله را می توان با تعریف مرجعهای مناسبی، بدون بعد نمود و با علامت بالانویس * نمایش داد.

$$y^{*} = \frac{y}{h}, x^{*} = \frac{x}{h}, \overline{B}^{*} = \frac{\overline{B}}{B_{0}},$$

$$\varphi^{*} = \frac{\varphi}{\varphi_{0}}, P^{*} = \frac{P}{\rho U_{0}^{2}}, \overline{V}^{*} = \frac{\overline{V}}{U_{0}},$$

$$\theta = \frac{T - T_{i}}{T_{\text{out}, 0} - T_{i}}, \overline{J}^{*} = \frac{\overline{J}}{\left(\frac{\sigma_{0}\varphi_{0}}{h}\right)} \qquad (A)$$

که در آن U_0 سرعت مرجع است و معمولاً از یک حل تحلیلی قابل استخراج است. T_i دمای سیال در ورودی، $T_{out,0}$ دمای حداکثر سیال در خروجی، φ_0 ، B_0 ، φ_0 و σ_0 به ترتیب مقادیر مرجع براى ولتاژ الكترودها، شدت شار مغناطيسى، لزجت دینامیکی سیال و هدایت الکتریکی سیال است. لازم به ذکر است که با اجرای یک حل تحلیلی برای مسئلهای که ۱ است، سرعت جریان در مجرا $L_e/L \neq$ و دمای سیال در خروج $U=(\sigma_0 arphi_0 B_0 h L_e)/\mu_0 L$ تغییر L_e است که متناسب با $T_{
m out} = T_i + (J^2 L_e / \sigma_0 \rho C_P U)$ می کند و قاعدتاً بایستی مرجع هر سرعت و دما در حوزه حل باشد؛ امّا با توجه به اینکه اغلب، مرجع هر کمیتی ثابت فرض می شود، در این مقاله سرعت و دما برای حداکثر Le (یعنی وقتی $L_e = L$)، به عنوان سرعت و دمای مرجع در نظر گرفته است؛ يعنى $U = \sigma_0 arphi_0 B_0 h/\mu_0$ و شدہ :در نتيجه داريم، $T_{\text{out}} = T_i + (J^2 L / \sigma_0 \rho C_P U)$ $\nabla \cdot \vec{V} = 0$ (٩)

$$\left(\vec{V}\cdot\nabla\right)\vec{V} = -\overrightarrow{\nabla P} + \frac{1}{\operatorname{Re}_{h}}\nabla^{2}\vec{V} + \frac{1}{\operatorname{Re}_{h}}\vec{J}\times\vec{B}$$
 (1.1)

$$\left(\vec{V}\cdot\nabla\right)\theta = \frac{1}{\text{Pe}}\nabla^2\theta + \frac{\text{Ec}}{\text{Ha}^2\text{Re}_{h}}\vec{J}^2 \tag{11}$$

$$\vec{I} = -\nabla \varphi + \text{Ha}^2 \vec{V} \times \vec{B} \tag{11}$$

$$\nabla^2 \varphi = \mathrm{Ha}^2 \nabla \cdot \left(\vec{V} \times \vec{B} \right) \tag{17}$$

$$\nabla^2 B = 0 \qquad \& \qquad \nabla \cdot \vec{B} = 0 \qquad (1\%)$$

که در آنها به منظور اختصار نویسی از علامت * چشم پوشی شده است و $\mathrm{Re}_{\mathrm{h}}=
ho U_{0}h/\mu_{0}$ عدد رینولدز حداکثر در مسئله، (نسبت نيروی اينرسی به لزجتی عدد هارتمن (نسبت نیروی لورنتز به Ha = $B_0 h \sqrt{\sigma_0/\mu_0}$ $Pe = Re_h \cdot Pr$ عدد اکرت و $Ec = U_0^2 / C_P T_{out,0}$ لزجت)، لزجت عدد پکلت، پارامترهای بیبعد حاکم بر مسئله میباشند. بعلاوه در این پژوهش، هدایت الکتریکی و لزجت دینامیکی $\sigma = \sigma_0 [1 + 0.025(T - T_0)]$ سيال به ترتيب با روابط وابسته $\ln\left(\frac{\mu}{\mu_0}\right) = -1.704 - 5.306\left(\frac{273}{T}\right) + 7.01\left(\frac{273}{T}\right)^2$ به دما تعریف شدهاند [۳]. که در آن ۲۹۸ K مای مرجع و T بر حسب کلوین است. همان طور که از این روابط مشاهده می شود، افزایش دما موجب کاهش نمایی لزجت و افزایش خطی هدایت الکتریکی خواهد شد. کاهش لزجت با افزایش دما در سیالات مایع، امری بدیهی است. کاهش لزجت، یکی از عوامل افزایش سرعت در ریزمجرا است و افزایش هدایت الکتریکی، باعث افزایش شدت جریان الکتریکی، نیروی حجمی لورنتز و تولید گرمای ژول میشود. قابل ذکر است که \mathcal{C}_P و ho سیال عامل مورد نظر، در محدوده تغییرات دمایی پژوهش حاضر، تغییرات ناچیزی دارند و لذا از تابعیت دمایی آنها صرفنظر شده است.

۲-۲- شرایط مرزی و خواص ترموفیزیکی مسئله

در مسئله مورد نظر، شرایط مرزی به این شرح است. در ورودی مجرا فشار و دما معلوم، امّا سرعت و میدان الکتریکی به صورت شرط مرزی نیومن^۱ است. در خروجی مجرا فشار معلوم، ولی سرعت، دما و میدان الکتریکی به صورت مشتقی

است. در سرتاسر دیوارههای بالا و پایین مجرا برای سرعت، شرط عدم لغزش بکار رفته، ولی برای میدان الکتریکی در خارج از محدوده الکترودها شرط مرزی مشتقی و در محدوده الکترودها، شرط مرزی میدان الکتریکی معلوم بکار رفته است که بهطور خلاصه طبق جدول ۱ گزارش شدهاند.

با توجه به اینکه شرایط مرزی حل معادلات میدان مغناطیسی بایستی در راستای z نیز بیان شود، مطابق جدول ۲ شرایط مرزی ناحیه دیوار به طور جداگانه گزارش شده است. در ورودی و خروجی، شرط مرزی هنوز از نوع مشتقی است.

قابل ذکر است که شرایط مرزی برای میدان مغناطیسی در صفحه xz استفاده میشود و با توجه به وضعیت دو بعدی مورد نظر در این پژوهش که در آن جریان در صفحه xy و با شرایط در موقعیت Y = b/ جاری است، فقط از مؤلف های میدان مغناطیسی در راستای z که حداکثر تابعی از x است، استفاده شده است. بعلاوه اگرچه معادله $0 = x^2B_x = -L$ میشود، امّا پاسخ آن در صفحه Y = b/ حال مفر است. خواص ترموفیزیکی بکار رفته در مسئله حاضر به طور خلاصه در جدول ۳ بیان گردیده است. این مشخصات ترموفیزیکی، مربوط به یک الکترولیت (آب دریا)است.

جدول ۱- شرایط مرزی سرعت، فشار، دما و میدان الکتریکی

ورودى	خروجى	ديوار عايق	ديوار الكترود
P = 0	P = 0	$\partial^2 p/\partial y^2 = 0$	$\partial^2 p / \partial y^2 = 0$
$\partial u/\partial x = 0$	$\partial u/\partial x = 0$	u = 0	u = 0
$\partial v / \partial x = 0$	$\partial v / \partial x = 0$	v = 0	v = 0
$T = T_i$	$\partial T/\partial x = 0$	$\partial T/\partial y = 0$	$\partial T/\partial y = 0$
$\partial \varphi / \partial x = 0$	$\partial \varphi / \partial x = 0$	$\partial \varphi / \partial y = 0$	$\varphi(x,h) = -\varphi_0$
			$\varphi(x,0) = +\varphi_0$

جدول ۲ - شرایط مرزی میدان مغناطیسی

دیوار در محدوده خارج از آهنربا	دیوار در محدوده آهنربا		
	$B_{\rm rr}(L_1 + L_{\rm Pr}, \mathbf{v}, \mathbf{h}) = -B_{\rm Pr}$		
$\partial B_{u}/\partial z = 0$	$B_{x}(L_{1}, v, 0) = -B_{0}$		
	$B_{x}(L_{1} + L_{P}, v, 0) = +B_{0}$		
$B_{z}(x, y, 0) = 0$	$B_r(L_1, y, b) = +B_0$		
	$B_{x}(L_{1} < x < L_{1} + L_{P}, y, 0) = 0$		
$B_z(x, y, b) = 0$	$B_x(L_1 < x < L_1 + L_P, y, b) = 0$		
	$B_z(x, y, 0) = B_z(x, y, b) = B_0$		

¹Neumann Boundary Condition

جدول ۳- ثابتها و خواص ترموفیزیکی در جریان ام اچ دی						
واحد	مشخصه مقدار		مشخصه			
$\frac{A}{m V}$ \downarrow $\frac{1}{\Omega m}$ \downarrow $\frac{Siemens}{m}$	۱/۵	σ_0	هدایت الکتریکی سیال،			
N s/m ²	•/••١	μ_0	لزجت دینامیکی سیال،			
kg/m ³	۱۰۰۰	ρ	چگالی سیال،			
V(Volts)	١٠	$arphi_0$	پتانسیل الکتریکی،			
Tesla يا <u>Vs</u> يا Tesla	۰/۰۲۵	B_0	شدت شار مغناطیسی،			
W/m K	۰/۶۱۳	k	هدایت حرارتی سیال،			
kJ/kg K	4/181	C_p	ظرفیت گرمایی سیال،			
К	298	T_i	دمای سیال ورودی،			

مشاهده می شود که اختلاف پتانسیل الکتریکی روی صفحه در الکترودها ($\Delta \varphi = \varphi(x,0) - \varphi(x,h)$ همواره ثابت و برابر ۲۰ ولت اختیار شده است.

۳-۳- حل عددی

در این پژوهش، برای حل عددی معادلات جریان ام اچ دی با شرایط مرزی و مشخصات هندسی بیان شده در بخش ۳-۲ از روش حجم محدود استفاده شده است. ارتباط بین میدان های سرعت و فشار از طریق الگوریتم سیمپل' برقرار شده است. برای پرهیز از اثرات احتمالی شطرنجی در میدان های فشار و سرعت از شبکه هم مکان با میان یابی رای- چو ۲[۲۳]، برای مقادیر سرعت روی وجوه استفاده شده است. برای ارزیابی توام جملات پخش و جابجایی در محل وجوه، از طرح قاعده توانی استفاده شده است. سیستم معادلات جبری با استفاده از الگوریتم ماتریس سه قطری به روش ضمنی جایگزینی جهات^۵ حل شده، نتایج تا دقت^{۱۶-} ۱۰ گزارش گردیده است. نتایج ارائه شده در این پژوهش با توجه به مقادیر ثابت جدول ۳، برای ۶/۸۲،Ha = ۰/۰۰۱ و $l \leq L_e/L \leq r$ استخراج شدہ است. که در این صورت Pr = با تغییر L_e رینولدز و پکلت جریان بین صفر و حداکثر خودشان يعنى ($Pe \ge Pe \ge 0$ و ($Pe \ge Pe \ge 0$) و ($Re_h \ge 10^{-1}$

¹ SIMPLE

متغیّر خواهد بود. یک نمونه از شبکه جبری تولید شده برای حل مسئله حاضر، در شکل ۳ نشان داده شده است. بعلاوه برای نشان دادن استقلال نتایج مهم جریان از ابعاد شبکه (مانند سرعت متوسط در مقطع) مسئله مورد نظر در بخش صحت سنجی برای شبکههای مختلف حل شده است. نتایج حاکی از آن است که برای شبکه ۲۵۰×۱۰۰ و ریزتر از آن، سرعت متوسط جریان سیال به عدد ^{۲–}۱۰×۳/۳ متر بر ثانیه همگرا شده و تا رقم چهارم اعشار ثابت باقی می ماند.

قابل ذکر است، در شکل ۳ به منظور وضوح بیشتر از تعداد گرههای کمتری استفاده شده، در نواحی ابتدایی و انتهایی الکترودها بعلاوه کنار دیوارهها، شبکه ریزتر شده است و نسبت تراکم برای این نواحی ۱۰۰۶ = *f* است.



شکل ۳- یک نمونه شبکه غیر یکنواخت تولید شده به روش جبری به ابعاد ۱۰۰×۲۵

۴- نتایج و بحث

۴–۱– صحت سنجی نتایج عددی

اعتبارسنجی برنامه عددی نوشته شده با مقایسه نتایج حل عددی جریان ام اچ دی بین دو صفحه موازی و یک حل تحلیلی انجام شده است. در این حل تحلیلی خاص بهطور غیرفیزیکی، از اثرات نفوذ جانبی میدان الکتریکی و مغناطیسی در خارج از فاصلههای $_{2} \ e$ $_{2} \ o$ صرفنظر شده، خواص سیال، $\mu_{0} \ e$ σ ثابت فرض شده است. بعلاوه تغییر طولهای $_{2} \ e$ $_{2} \ f$ ثابت فرض شده است. بعلاوه تغییر در این صورت، پاسخ میدانهای الکتریکی و مغناطیسی به ترتیب، $(1 \ e) \ e = -E \ w$ است. معادلات (۱۵) تا این حل تحلیلی نشان می دهد [۲۳ و ۲۴].

² Rhie-Chow

³ Power Law

⁴ Tridiagonal Matrix Algorithm (TDMA)

⁵ Alternative Direction Implicit (ADI)

$$u(y) = -\left(\frac{\sigma_0 B_0 E}{\mu_0}\right) \left(\frac{h}{Ha}\right)^2 \left[1 - \frac{1}{\frac{Ha}{1+e}\sqrt{\frac{Le}{L}}} \left(e^{\frac{Ha}{h}y\sqrt{\frac{Le}{L}}} + e^{\frac{Ha}{h}\left(1 - \frac{y}{h}\right)\sqrt{\frac{Le}{L}}}\right)\right]$$
(12)

$$P(x) = \begin{cases} -Mx & , \ 0 \le x < L_1 \\ \left[\frac{1}{L_e} - 1\\ -Mx + ML & , \ L_1 \le x \le L_1 + L_e \\ -Mx + ML & , \ L_1 + L_e < x \le L \end{cases}$$

$$(19)$$

$$\mathcal{D} = \begin{cases} \left(\frac{1}{\gamma}\right) \left[1 - e^{-\gamma}\right] e^{X\gamma} &, 0 \le x < L_{1} \\ \left(\frac{1}{\gamma}\right) \left[1 - e^{-\gamma}\right] e^{-\gamma} \left[1 - X\right] &, L_{1} \le x \le L_{1} + L_{e} \\ 1 &, L_{1} + L_{e} < x \le L \end{cases}$$
(19)

که در آن $\theta(x) = (T(x) - T_i)/(J^2L_e/\sigma_0\rho C_P U_{ave})$ و $X = (x - L_1)/L_e$ $\gamma = U_{ave}L_e/\alpha$ $\alpha = \frac{k}{\rho C_P}$ است.

کل ۴، نتایج عددی یک پروفیل سرعت در مقطعی دلخواه از مجرا را با حل تحلیلی معادله (۱۵) برای وضعیت $L_e = L_P = ... 0$ مقایسه می کند. مشاهده می شود که انطباق نتایج برای این وضعیت، کاملاً قابل قبول است. شکل ۵، توزیع فشار القایی در سراسر حوزه حل روی خط مرکزی مجرا را نشان می دهد. مشاهده می شود که انطباق کاملی بین نتایج عددی و حل تحلیلی معادله (۱۶) وجود دارد. شکل ۶، توزیع دمای میانگین در سراسر مجرا را با حل تحلیلی (۱۷) مقایسه می کند. مشاهده می شود که انطباق نتایج برای این وضعیت، قابل قبول است.





سکل ۵- مفایسه نوریع فسار بدست آمده از تنایج عددی حل تحلیلی



عددی و حل تحلیلی

۴–۲– نتایج عددی تغییر طول مستقل میدانهای الکترومغناطیسی

همان طور که پیش از این بیان شد، بررسی اثر تغییرات طولی میدان های الکترومغناطیسی (در راستای جریان) روی طرح جریان و میدان دما، دارای اهمیت است. نویسندگان مقاله حاضر طی مقالههای [۲۵، ۲۶ و ۲۷]، تغییرات همزمان این طول ها را روی طرح جریان، توزیع دما و راندمان پمپاژ بررسی نمودهاند. در مقاله حاضر، مقصد این است که رفتارهای دینامیکی و ترمودینامیکی یک ریز پمپ ام اچ دی درحالی بررسی می شود که طول دو میدان الکترومغناطیس آن به طور مستقل از هم تغییر می نماید. بعلاوه در این مقاله،

ضمن درنظر گرفتن نواحی نفوذ میدانهای الکتریکی و مغناطیسی، به منظور نشان دادن اثرات وابستگی دمایی خواصی از سیال مانند μ و σ ، نتایج حاصل از تغییر طول مستقل این دو میدان در دو بخش مجزا بررسی و بیان می-شود. در بخش اول، مشابه بخش صحت سنجی از وابستگی دمایی خواص به طور غیر فیزیکی صرف نظر می شود، حال آنکه در بخش دوم، این وابستگی دمایی ابقاء می شود. هر یک از بخش های ذکر شده، نتایج مربوط به دو حالت را گزارش می کند. در حالت اول، L = 2 ثابت و L متغیّر است. حال آنکه در حالت دوم، L = 2 ثابت و L متغیّر است. لازم به ذکر است، در حالتی تاثیرگذار است که L = a ثابت و Lتغییر می کند، فقط ناحیه نفوذ میدان مغناطیسی است. بلعکس در حالتی که L = L ثابت و L تغییر می می ماید،

۴-۲-۴- نتایج مربوط به بخش اول (خواص ثابت)

در این بخش، دو حالت متفاوت از تغییر طول دو میدان الکتریکی و مغناطیسی (در راستای جریان) بررسی و نتایج آن گزارش میشود. در حالت اول، طول میدان الکتریکی ثابت و برابر طول ریز مجرا اختیار شده است (L = a)؛ درحالی که طول میدان مغناطیسی بین صفر تا L تغییر مینماید $(\cdot \ge L_p/L \ge 1)$. در حالت دوم، طول میدان مغناطیسی ثابت و برابر طول ریزمجرا اختیار شده است (L = a)؛ درحالی که طول میدان الکتریکی بین صفر تا L تغییر مینماید .

(العام L_P والت اول L_e ثابت و L_P متغيّر L_P

در این حالت، از آنجا که میدان الکتریکی بر سراسر مجرا اعمال شده، میدان مغناطیسی متغیر است، فقط ناحیه نفوذ جانبی مغناطیسی تاثیرگذار است؛ درنتیجه در این حالت، نتایج مربوط به میدان مغناطیسی مشابه با نظیرش در حالت تغییر طول همزمان دو میدان است. شکل ۷، نتایج عددی میدان مغناطیسی را برای وضعیت L 0 - = x نشان می-دهد. همان طور که قبلاً نیز بیان شد، میدان مغناطیسی در راستای z اعمال شده است و خطوط آن از صفحه xz عبور میناید، در حالی که جریان دوبعدی در صفحه xy و با شرایط در موقعیت Z = b/T مورد نظر است. همان طور که شرایط در موقعیت z = b/T

 B_x در تغییر طول همزمان، در موقعیت z = b/7 ، مؤلفه B_x میدان مغناطیسی صفر خواهد بود و تنها مؤلفه B_z آن مقدار دارد که در شکل ۲– (ب) توزیع B_z بر حسب x نشان داده شده است.



شکل ۲– نتایج عددی، (الف) خطوط میدان مغناطیسی در صفحه z = b/ و (ب) تغییرات B_z در راستای x در z

شکل ۸، نتایج عددی را بهترتیب برای توزیع میدان و بردار شدت جریان الکتریکی، فشار، سرعت و دما در وضعیت ($L_P = -I_P = L_P = L_P$) در صفحه χx نشان میدهد. در شکل ۸- (الف) مشاهده میشود از آنجا که میدان الکتریکی در سراسر مجرا اعمال شده است، نواحی نفوذ جانبی میدان الکتریکی در خارج از محدوده طول مجرا قرار میگیرد؛ در نتیجه میدان الکتریکی در سراسر مجرا کاملاً خطی است و تراکم خطوط بردار شدت جریان الکتریکی در سراسر مجرا فشار، در عرض مجرا کاملاً یکنواخت و در هر مقطعی یکسان فشار، در عرض مجرا کاملاً یکنواخت و در هر مقطعی یکسان سراسر حوزه کاملاً یکسان مشاهده میشود. از شکل ۸- (د) مساهده میشود که حرارت تولیدی ناشی از گرمایش ژول به-مشاهده میشود که حرارت تولیدی ناشی از گرمایش ژول به-دلیل عبور جریان سیال کاملاً به سمت پایین دست کشیده شده است.



شکل ۸- نتایج عددی در مقطع z = b/۲ (الف) میدان و بردار شدت جریان الکتریکی، (ب) میدان فشار، (ج) میدان سرعت و (د) میدان دما

 $\phi = +10 \text{ V}$

(3)

شکل ۹، دبی جریان به ازای تغییرات طول مستقل میدان مغناطیسی (L_p) را نشان میدهد. دبی از رابطه $Q = \int u(y)b \, dy$ محاسبه شده است. همان طور که مشاهده میشود، با افزایش طول میدان مغناطیسی دبی جریان در مجرا به صورت خطی افزایش مییابد. این افزایش دبی را می-مجرا به کمک شکل ۱۰ که در آن رشد پروفیلهای سرعت نمایش داده شده است، توجیه کرد. در شکل ۱۰ مشاهده میشود که با افزایش L_p/L پروفیلهای سرعت بزرگتری میشود که با افزایش L_p/L پروفیلهای سرعت بزرگتری تفسیر است که در آن نیروی لورنتز عامل حرکت است. با توجه به اینکه نیروی لورنتز وابسته به حضور دو میدان الکتریکی و مغناطیسی متعامد است، در این حالت که میدان الکتریکی در سراسر مجرا اعمال شده و طول میدان مغناطیسی متغیّر است، فقط در نواحی حضور هر دو میدان، شده روی شکل جهت افزایش L_P/L را نشان می دهد و درست به همین دلیل که بعد از $\Lambda/L = 1/2$ تغییر تغییرات شیب نسبت به افزایش L_P/L معکوس می شود و در منحنی برای نشان دادن تغییرات $P/\rho U_0^2$ بر حسب L_P/L بکار رفته است.





واضح است که اگر L_p/L صفر باشد، هیچ جریانی در مجرا برقرار نیست و گرادیان فشاری نیز موجود نخواهد بود. با مقدار گرفتن L_p/L بر منطقه میانی مجرا، نیرویی بر سیال وارد شده، سیال شروع به جاری شدن می کند. اصل بقای جرم لازم می دارد که یک گرادیان فشار مطلوبی برای نواحی خارج از L_p مجرا القا شود. با افزایش L_p و در نتیجه دبی نیروی لورنتز وجود دارد. به عبارت دیگر، طبق معادله ممنتوم، نیروی لورنتز در ناحیه اثر میدانهای الکترومغناطیس به صورت $\forall B (A \times B) \int$ است که این انتگرال در ناحیه L_P محاسبه می شود و واضح است با افزایش L_P مقدار محاسبه شده آن زیاد می شود.



مغناطيسي (خواص ثابت)



شکل ۱۰– توزیع سرعت به ازای تغییر طول مستقل میدان مغناطیسی (خواص ثابت)

شکلهای ۱۱ و ۱۲، توزیع فشار القایی به ازای تغییر طول مستقل میدان مغناطیسی (به ازای $L_e = L$) را نشان میدهند. مشاهده میشود که در این حالت با افزایش طول مستقل میدان مغناطیسی در منطقه ورودی، یک فشار القایی منفی و در منطقه خروجی یک فشار القایی مثبت ایجاد شده است؛ بهطوری که در دو ناحیه ورودی و خروجی، یک گرادیان فشار منفی (مطلوب) حاصل شده است و در ناحیه میانی یک گرادیان فشار مثبت (نامطلوب) القاء گردیده است. فلش رسم

جریان، این گرادیان فشار نیز رشد می نماید؛ امّا طبیعی است که در یک جایی متوقف شود؛ زیرا اگر $L_P = L$ شود، مجدداً نیازی به حضور گرادیان فشار القایی نیست. این مطلب را می توان در شکل ۱۳ تحقیق کرد که در آن فشار القایی منطقه ورودی و خروجی مجرا برحسب L_P/L رسم شده است.

در شکل ۱۴، تغییرات شیب فشار در سه منطقه از مجرا L_P نشان داده شده است. مشاهده میشود، اگرچه با افزایش $(L - 1)^{1/2}$ روند تغییرات توزیع فشار در یک وضعیت خاص ($L - 1^{1/2}$ $L_P = L_2$) معکوس میشود، امّا تغییرات شیب فشار در هر سه منطقه همواره روندی یکسان دارند؛ یعنی در منطقه L_1 و L_2 همواره نزولی و منفی، در منطقه L_P همواره نزولی و مثبت است. علت این امر، به تغییر همزمان صورت و مخرج dP/dxبرمی گردد.

شکل ۱۵، تغییرات فشار در مرکز و کنار دیوارههای مجرا را برای وضعیت ($L_P = \cdot/\Delta L$) نشان میدهد. مشاهده می-شود که در مرکز و کنار دیوارهها، حتی در نواحی ابتدایی و انتهایی طول میدان مغناطیسی، تغییرات فشار یکسان است.

شکل ۱۶، توزیع دمای میانگین کاسهای را در سراسر مجرا به ازای تغییر طول مستقل میدان مغناطیسی نشان داده است. دمای میانگین کاسهای از رابطه محاسبه شده $T_m = \left[\int u(x,y)T(x,y)dA\right] / \left[\int u(x,y)dA\right]$ است که در آن $dA = b \; dy$ است. مشاهده می شود، در این حالت که میدان الکتریکی سراسر مجرا اعمال شده است، اختلاف دمای بسیار زیادی از ابتدا تا انتهای مجرا رخ میدهد. بهطوری که با افزایش L_P/L این اختلاف دما کاهش می یابد؛ علت این امر، افزایش سرعت جریان سیال است که با افزایش L_P/L افزایش می یابد. با توجه به ثابت بودن طول میدان الکتریکی ($L_e = L$)، همواره حرارت بواسطه گرمایش ژول به جریان اضافه می شود، حال زمانی که مثلاً طول میدان مغناطیسی به طور مستقل افزایش می یابد، با توجه به افزایش دبی جریان و در نتیجه افزایش عدد پکلت، سیال در فاصله طول مجرا L فرصت کمتری مییابد تا در نتیجه حرارت اعمال شده افزایش دما دهد. لذا با افزایش L_P شیب توزیع دما كمتر مى شود.



شکل۱۳– تغییرات فشار در ابتدا و انتهای میدان مغناطیسی با تغییر طول مستقل میدان مغناطیسی (خواص ثابت)



شکل ۱۴– تغییرات شیب فشار در طول مجرا به ازای تغییر طول مستقل میدان مغناطیسی (خواص ثابت)



(خواص ثابت)



شکل ۱۶- توزیع دمای میانگین کاسهای در سراسر مجرا به ازای تغییر طول مستقل میدان مغناطیسی (خواص ثابت)

(العناية L_e متغيّر L_P متغيّر L_P متغيّر L_e

نتایج عددی نشان داد، در این بخش با توجه به اینکه میدان مغناطیسی در سراسر مجرا و در راستای z اعمال شده است و خطوط آن از صفحه xz عبور مینماید، نواحی نفوذ جانبی این میدان در خارج از محدوده مجرا قرار می گیرد؛ در نتیجه در این حالت مؤلفه $0 = _x B$ و فقط مؤلفه $_z B$ دارای مقدار است که به صورت خط راست و تابعی از x است (یادآوری می شود که مؤلفه $_x B$ در حالت قبلی در T/d = z مقدار صفر داشته و در موقعیتهای دیگر دارای مقداری ناچیز است).

شکل ۱۷، نتایج عددی را برای توزیع میدان الکتریکی، $(L_P = L \ e = \cdot/\Delta \ L)$ و $L_e = \cdot/\Delta \ L$ و $L_P = L \ e$ نشان مىدهد. شكل ١٧- (الف)، خطوط همتراز ميدان الکتریکی و شدت جریان الکتریکی را نشان میدهد که در آن ميدان الكتريكي بويژه در منطقه مياني الكترودها كاملأ خطي است و خطوط شدت جریان الکتریکی، کاملاً در منطقه نفوذ جانبی مقدار غیر صفر دارد. در شکل ۱۷- (ب)، مشاهده می-شود که میدان فشار، در عرض مجرا (مانند حالت قبلی) یکنواخت نیست، بویژه در ناحیه اتصال دیوارههای عایق با الكترودها طرح كاملأ متفاوتي دارد كه اثر مستقيم نفوذ میدان الکتریکی در این نواحی است. با این وجود در شکل ۱۷- (ج)، پروفیلهای سرعت در سراسر حوزه کاملاً یکسان می باشند. از شکل ۱۷- (د)، مشاهده می شود که حرارت تولیدی ناشی از گرمایش ژول بهدلیل عبور جریان سیال کاملاً به سمت پایین دست کشیده شدهاند. بعلاوه مشاهده مى شود كه در ناحيه نفوذ جانبى بالادست توزيع دما تحت تاثیر شدت جریان الکتریکی است.



شکل ۱۷– نتایج عددی در مقطع z = b/۲ (الف) میدان و بردار شدت جریان الکتریکی، (ب) میدان فشار، (ج) میدان سرعت و د) میدان دما

می توان نتیجه گرفت که اثرات نواحی نفوذ جانبی میدان الکتریکی بر طرح جریان، موثرتر از نظیرش در میدان مغناطیسی است. اینکه نیروی لورنتز فقط در محلی از مجرا در فاصلهای محدود اعمال می شود، عامل تغییر توزیع فشار و سرعت نمیباشد. نتیجهای که قبلاً نیز به آن اشاره شده است؛ یعنی با توجه به یکنواخت بودن توزیع نیرو در عرض مجرا، همواره یک جریان توسعه یافته بوجود خواهد آمد. با این وجود، نتایج عددی نشان داد که تغییرات شیب و مقدار فشار، ایکتریکی از نظر مقدار و روند تغییر مشابه به شکلهای ۹ تا شده است. آنچه که در این حالت متفاوت است، توزیع فشار در مرکز و دیوارههای مجرا و توزیع دما است که در شکل ۸ در مرکز و دیوارههای مجرا و توزیع دما است که در شکل ۸۸

شکل ۱۸، توزیع فشار در مرکز و دیوارههای مجرا را در وضعیت ($L_P = L_e = L_e = ...$ نشان می دهد. مشاهده می شود که تغییرات فشار در مرکز و دیوارهها دیگر یکسان نیست و در نواحی ابتدایی و انتهایی طول میدان الکتریکی کاملاً متفاوت است. علت این امر، تراکم خطوط شدت جریان الکتریکی است که در منطقه نفوذ جانبی دارای مقدار است یا به عبارتی، اثر نواحی نفوذ جانبی میدان الکتریکی موثرتر از نظیرش در میدان مغناطیسی است.

در شکل ۱۹، توزیع دمای میانگین کاسهای در سراسر مجرا به ازای تغییر طول مستقل میدان الکتریکی نشان داده شده است. با کمال تعجّب مشاهده میشود، در تمام حالات اختلاف دمای تقریباً یکسانی رخ میدهد، امّا با توجه به تغییر طول L_e شیب تغییرات دما نیز تغییر مینماید. بهطوری که با افزایش L_e/L شیب تغییرات دما ثابت است. علت تغییر دمای یکسان از ورودی به خروجی با توجه به افزایش L_e این است که سرعت جریان سیال نیز با افزایش L_e زیاد میشود و لذا سیال فرصت کمتری برای دریافت حرارت بیشتر دارد.

۴-۲-۲- نتایج مربوط به بخش دوم (خواص وابسته به دما)

عبور جریان الکتریکی از درون سیال در جریانهای ام اچ دی به معنای افزایش مصرف انرژی الکتریکی است، بهطوری-که بخش زیادی از انرژی ورودی به انرژی داخلی سیال تبدیل شده، دمای سیال را افزایش میدهد؛ درنتیجه خواص سیال از جمله، σ ، μ ، ρ ، μ ، σ ، تحت تاثیر این افزایش دما قرار خواهد گرفت. همان طور که پیش از این بیان شد، R_P ، و ho سیال عامل مورد نظر، در محدوده تغییرات دمایی پژوهش حاضر، تغییرات ناچیزی دارند و لذا از تابعیت دمایی σ آنها صرفنظر شده است. چنانچه از تابعیت دمایی خواص و μ صرفنظر شود، یک حذف غیرفیزیکی انجام شده است که در بخش قبلی، فقط صرف درک بهتر نتایج و بیان تاثیرات وابستگی دمایی خواص سیال، این حذف غیرفیزیکی انجام شده است. حال با توجه به بیان تاثیرات گرمایش ژول در این بخش، نتایج با تابع دما در نظر گرفتن لزجت دینامیکی و هدایت الکتریکی سیال عامل (r و µ) بیان می شود؛ در نتیجه اگرچه خواص ترموفیزیکی سیال یعنی، σ و μ تابع دما میباشند، امّا پاسخ طرح کلی میدانهای سرعت، فشار، دما،





شکل ۱۹- توزیع دمای میانگین کاسهای در سراسر مجرا با تغییر طول مستقل میدان الکتریکی (خواص ثابت)

پتانسیل الکتریکی و مغناطیسی در هر دو حالت از بخش قبلی، مطابق آنچه گزارش شده است در شکلهای ۲، ۸ و ۱۷ میباشد که به منظور اختصار بیشتر، از ارائه آنها در هر دو حالت صرفنظر شده است.

(متغیّر) اول (L_P ثابت و L_P متغیّر L_e

شکل ۲۰، دبی جریان به ازای تغییر طول مستقل میدان مغناطیسی را نشان میدهد. مشاهده میشود که با اعمال وابستگی دمایی دبی جریان به ازای افزایش طول مستقل میدان مغناطیسی نسبت به وضعیت ثابت بودن خواص با شیب متوسط بسیار بیشتری افزایش مییابد. از طرف دیگر مشاهده میشود، در L_P/L شیب نمودار زیاد، امّا در $L_P/L = M$ شیب نمودار کم میشود؛ بهطوری که شیب

متوسط نسبت به وضعیت ثابت بودن خواص حدود ۵ برابر است. این تغییر در روند افزایش دبی را میتوان به صورت زیر تفسیر کرد. با توجه به اینکه میدان الکتریکی در سراسر مجرا اعمال شده است، جریان الکتریکی عبوری از درون سیال باعث میشود که سیال در سراسر مجرا افزایش دمای زیادی پیدا کند و در نتیجه با اعمال تابعیت دمایی خواص سیال، لزجت دینامیکی سیال که عاملی مقاوم در برابر حرکت سیال است، دچار کاهش میشود. با توجه به روند تغییرات نمایی لزجت دینامیکی سیال که ابتدا با شیب زیاد و سپس با شیب کم تغییر می کند، دبی جریان در مجرا ابتدا با شیب بیشتر و ثابت بودن خواص حداکثر دبی حدود ۲۰ میلی لیتر بر ثانیه است، در حالی که در شکل ۲۰، حداکثر دبی حدود ۲۵ میلی لیتر بر میلی لیتر بر ثانیه است.

شکل ۲۱، پروفیلهای سرعت جریان به ازای تغییر طول مستقل میدان مغناطیسی را نشان میدهد. مشاهده میشود که با افزایش L_p/L پروفیلهای سرعت بزرگتری، نسبت به بخش وضعیت ثابت بودن خواص حاصل میشود و حداکثر سرعت در مرکز مجرا است. افزایش دبی در شکل ۲۰ را می-توان به کمک شکل ۲۱، توجیه نمود. به عبارت دیگر در این شکل، حداکثر پروفیلهای بیبعد سرعت از ۲/۰ تا ۹/۰ افزایش مییابند؛ درحالیکه با توجه به شکل ۱۰ حداکثر پروفیلهای بیبعد سرعت از ۲۰۰۵ تا ۲/۱۰ افزایش مییابند. علت این امر را میتوان به لزجت دینامیکی سیال مربوط ساخت که عاملی مقاوم در برابر حرکت سیال است. همان طور که در انتهای بخش ۳–۱ بیان گردید، لزجت با افزایش دما کاهش مییابد و لذا با کاهش لزجت سرعت جریان در مجرا افزایش مییابد.

شکل ۲۲، توزیع دمای میانگین کاسهای را در سراسر مجرا به ازای تغییر طول مستقل میدان مغناطیسی نشان میدهد. مشاهده میشود که با افزایش طول مستقل میدان مغناطیسی، دمای میانگین کاسهای در طول مجرا کاهش میابد. به عبارت دیگر، اگرچه در هر نقطه از سیال در منطقه الکترودها با ابقاء وابستگی دمایی حرارت بیشتری تولید میشود، امّا به دلیل افزایش سرعت جریان، دمای سیال خروجی کمتر میشود. لذا همان طور که در این شکل مشاهده میشود، با اعمال وابستگی دمایی خواص حداکثر دما



شکل ۲۰ – دبی جریان به ازای تغییر طول مستقل میدان

مغناطيسي (خواص وابسته به دما)



شکل ۲۱– توزیع سرعت به ازای تغییر طول مستقل میدان مغناطیسی (خواص وابسته به دما)



شکل ۲۲- توزیع دمای میانگین کاسهای در سراسر مجرا به ازای تغییر طول مستقل میدان مغناطیسی (خواص وابسته به دما)

250

200

150 2 (mlit/s)

100

50



شکل ۲۳ – دبی جریان به ازای تغییر طول مستقل میدان

الكتريكي (خواص وابسته به دما)



شکل ۲۴ – توزیع سرعت به ازای تغییر طول مستقل میدان الكتريكي (خواص وابسته به دما)

به عبارت دیگر، اگرچه در هر نقطه از سیال در منطقه الكترودها با ابقاء وابستكي دمايي حرارت بيشتري توليد مي-شود، امّا به دليل افزايش سرعت جريان، دماي سيال خروجي کمتر می شود. لذا همان طور که در این شکل مشاهده می-شود، با اعمال وابستگی دمایی خواص، حداکثر دما میانگین حدود ۳۵ درجه سانتی گراد است، درحالی که در حالت ثابت بودن خواص (مطابق شکل ۱۹)، حداکثر دمای میانگین حدود ۵۰ درجه سانتی گراد و ثابت است. همان طور که در توضيحات شكل ٢٢ بيان شد، در واقع عبور جريان الكتريكي از سیال، به معنای مصرف انرژی الکتریکی است که تنها مقدار کمی از این انرژی به انرژی جنبشی سیال و به تبع افزايش دما تبديل مىشود. میانگین حدود ۴۵ درجه سانتی گراد است؛ درحالی که در حالت ثابت بودن خواص (مطابق شکل ۱۶)، حداکثر دمای میانگین به حدود ۱۴۰ درجه سانتیگراد میرسد. عبور جریان الکتریکی از سیال، به معنای مصرف انرژی الکتریکی است که تنها مقدار کمی از این انرژی، به انرژی جنبشی سیال تبدیل میشود. مقدار زیادی از این انرژی ورودی به انرژی داخلی سیال تبدیل شده، منجر به افزایش دمای سیال می شود.

(المتغيّر L_P حالت دوم L_P ثابت و L_P متغيّر L_P

شکل ۲۳، دبی جریان به ازای تغییر طول مستقل میدان الکتریکی را نشان میدهد. مشاهده میشود که با اعمال وابستگی دمایی دبی جریان به ازای افزایش طول مستقل ميدان الكتريكي، نسبت به وضعيت ثابت بودن خواص با شيب بسیار بیشتری افزایش مییابد. نتایج عددی نشان داد که در حالت ثابت بودن خواص با تغيير طول مستقل ميدان الکتریکی، حداکثر دبی حدود ۷۰ میلی لیتر بر ثانیه است، در حالی که در شکل ۲۳ حداکثر دبی حدود ۲۵۰ میلیلیتر بر ثانيه است.

شکل ۲۴، پروفیلهای سرعت جریان به ازای تغییر طول مستقل میدان الکتریکی را نشان میدهد. مشاهده میشود که با افزایش L_e/L پروفیلهای سرعت بزرگتری نسبت به بخش وضعیت ثابت بودن خواص حاصل می شود و حداکثر سرعت در مرکز مجرا است. افزایش دبی در شکل ۲۳ را می توان به کمک شکل ۲۴، توجیه نمود. در این شکل مشاهده می شود که با افزایش L_e/L پروفیلهای سرعت بزرگتری نسبت به بخش قبلی در حالت دوم حاصل می شود. به عبارت دیگر، در این شکل حداکثر پروفیلهای بیبعد سرعت حداکثر از نزدیک ۲/۲ تا ۱/۹ افزایش مییابند؛ در حالی که با توجه به نتایج مشاهده شده حداکثر پروفیلهای بیبعد سرعت از ۰/۰۵ تا ۰/۲۵ افزایش مییابند. علت این امر را می توان به لزجت دینامیکی سیال مربوط ساخت که عاملی مقاوم در برابر حركت سيال است.

شکل ۲۵، توزیع دمای میانگین کاسهای را در سراسر مجرا به ازای تغییر طول مستقل میدان الکتریکی نشان میدهد. مشاهده می شود که با افزایش مستقل طول میدان الکتریکی، دمای میانگین کاسهای در طول مجرا کاهش می یابد. مغناطیسی ۲۵۰/۰ تسلا و قدرت میدان الکتریکی ۲۰ ولت بر میلیمتر، دبی عبوری به ۲۵۰ میلیلیتر بر ثانیه می رسد و دمای میانگین کاسهای از ۲۵ درجه سانتی گراد ورودی، به ۴۵ درجه سانتی گراد برای حالت تغییر طول مستقل میدان معناطیسی و ۳۵ درجه سانتی گراد، برای حالت تغییر طول مستقل میدان الکتریکی در خروج از مجرا می رسد. این در حالی است که با ثابت بودن خواص، حداکثر دبی به ۲۰ میلیلیتر بر ثانیه می رسد و دمای میانگین کاسهای به حدود ۱۴۰ درجه سانتی گراد برای حالت تغییر طول مستقل میدان معناطیسی و به ۵۰ درجه سانتی گراد، برای حالت تغییر معناطیسی و به ۵۰ درجه سانتی گراد، برای حالت تغییر

8- مراجع

- Laser DJ, Santiago JG (2004) A review of micropumps. J Micromech Microeng 14: R35– R64.
- [2] Nisar A, Afzulpurkar N, Mahaisavariya B, Tuantranont A (2008) MEMS-based micropumps in drug delivery and biomedical applications. Sens. Actuators B (130): 917–942.
- [3] Vaibhav DP (2007) Electroosmosis and thermal effects in magnetohydrodynamic (MHD) micropumps using 3D MHD equations. In Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree Masters of Science thesis, Department of Mechanical Engineering, San Diego State University.
- [4] Mirbozorgi SA, Niazmand H, Renksizbulut M (2006) Electro-osmotic flow in reservoirconnected flat microchannels with non-uniform zeta potential. J F Eng 128: 1133-1143.
- [5] McBride SE, Moroney RM, Chiang W (1998) Electrohydrodynamic pumps for highdensity micro fluidic arrays. in: D.J. Harrison, A. vanden Berg Eds., Proceedings of Micro Total Analysis Systems Conference, Banff, Canada, 45–48.
- [6] Ashraf MW, Tayyaba S, Afzulpurkar N (2011) Micro Electromechanical Systems (MEMS) Based microfluidic devices for biomedical applications. Int J Molecular Sci 12: 3648-3704.
- [7] Antonio R (2007) Electrohydrodynamic and magnetohydrodynamic micropumps. Microfluidic Technologies for Miniaturized Analysis Systems, Department to Electronically Electromagnetisms Universidad de Sevilla.
- [8] Ritchie W (1833) Experimental researches in electro-magnetic and magneto-electricity. Philosophical Transactions of the Royal Society of London, 313-321.



ازای تغییر طول مستقل میدان الکتریکی (خواص وابسته به دما)

۵– نتیجه گیری

در این مقاله، اثر تغییرات مستقل طولهای دو میدان الکتریکی و مغناطیسی با اعمال وابستگی دمایی خواص سیال و لحاظ نواحی نفوذ جانبی بررسی و یک حل تحلیلی جامع شامل، توزیع سرعت، فشار و دما برای وضعیت خاص سرعت، فشار، دما و الکترومغناطیس با حل معادلات مربوطه سرعت، فشار، دما و الکترومغناطیس با حل معادلات مربوطه برای هر دو حالت از تغییر مستقل طولهای دو میدان به-طول میدان الکتریکی، مقدار جریان الکتریکی عبوری از درون سیال افزایش می ابد که در نتیجه، موجب تولید بیشتر حرارت و دبی می شود. افزایش دما خواص ترموفیزیکی سیال را تحت تأثیر قرار می دهد؛ به گونهای که لزجت به صورت نمایی کاهش یافته، در حالی که هدایت الکتریکی سیال به طور خطی افزایش می یابد.

بعلاوه نتایج نشان داد که اثر نواحی نفوذ جانبی میدان الکتریکی، به مراتب بیشتر از نظیر آن میدان مغناطیسی است و در هر دو حالت، از تغییر مستقل دو میدان در بخش خواص ثابت، دبی جریان، سرعت و تغییرات فشار روند افزایشی یکسان و به یک اندازه دارد. بهطوریکه با در نظر گرفتن تابعیت دمایی خواص، تغییرات فشار روندی یکسان، امّا دبی و سرعت جریان متفاوت است. بعلاوه نتایج عددی نشان داد که با تغییر طول مستقل دو میدان الکتریکی و مغناطیسی و لحاظ تابعیت دمایی خواص سیال (آب)، برای جریان در یک مجرا به مقطع مستطیلی ۱۰۰۰ میلی متر مربع، شدت شار

- [21] Tillack MS, Morley NB (1998) Magnetohydrodynamics. Standard Handbook for Electrical Engineers, 14th Edition.
- [22] Hughes M, Perilous KA, Cross M (1995) The numerical modeling of DC electromagnetic pump and brake flow. Appl Math Modelling 19: 713-724.
- [23] Chang CY (2004) Analysis of meso-scale heat exchangers with Magneto-hydrodynamic pump. [Ph.D. thesis], Department of Power Mechanical Engineering, sing Hua University.

[۲۴] دلاکه نژاد م، (۱۳۹۲) شبیه سازی عددی اثرات گرمایش ژول در جریان دیناموهیدرومغناطیسی (ام اچ دی) درون یک ریز مجرای تخت. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه بیرجند.

- [۲۵] دلاکه نژاد م، میربزرگی سع (۱۳۹۲) بررسی عددی تغییر طول همزمان میدانهای الکترومغناطیس روی رفتار دینامیکی یک ریزپمپ دیناموهیدرومغناطیسی(ام اچ دی). پانزدهمین کنفرانس دینامیک شارمها، بندرعباس، دانشگاه هرمزگان.
- [۲۶] دلاکه نژاد م، میربزرگی سع (۱۳۹۳) تحلیل عددی رفتار ترمودینامیکی یک ریز پمپ ام اچ دی با تغییر همزمان طول-های دو میدان الکتریکی و مغناطیسی. مجله مهندسی مکانیک مدرس، دوره ۱۴، شماره ۶، ص ص ۹۱–۹۸.
- [۲۷] دلاکه نژاد م، میربزرگی سع (۱۳۹۳) بررسی عددی راندمان پمپاژ یک الکترولیت توسط ریز پمپ ام اچ دی. بیست و دومین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایران، اهواز، دانشگاه شهید چمران.

- [9] Homsy A (2006) Design, microfabrication, and characterization of MHD pumps and their applications in NMR environments. [Ph.D. thesis], Institute of Microtechnology University of Neuchatel Rue Jaquet-Droz 1, CH-2002 Neuchatel Switzerland.
- [10] Jang J, Lee SS (2000) Theoretical and experimental study of MHD micropump. Sens. Actuators 80, 84-89.
- [11] Winowich NS, Hughes WF, Ramos JI (1987) Numerical simulation of electromagnetic pump flow. Numerical Methods in Laminar and Turbulent Flow 5: 1228-1240.
- [12] Ramos JI, Winowich NS (1990) Finite difference and finite element methods for MHD channel flows. Int J Num Methods Fluids 11: 907-934.
- [13] Lemoff AV, Lee AP, Miles R, McConaghy C (1999) An AC magneto-hydrodynamic micropump. towards a true integrated micro-fluidic system. Int Conf on Solid-State Sensors and Actuators Transducers 99: 1126-1129.
- [14] Lemoff AV, Lee AP (2000) An AC magnetohydrodynamic micropump. Sens. Actuators B 63, 178-185.
- [15] Zhong J, Yi M, Bau H (2002) Magnetohydrodynamic (MHD) pump fabricated with ceramic tapes. Sens. Actuators. 96: 59-66.
- [16] Je EH (2008) Characteristic study of MHD Minipump. J Mar Sci Tech (3): 234-237.
- [17] Duwairi HM, Abdullah M (2007) Thermal and flow analysis of a magneto-hydrodynamic micropump. Microsyst Technol 13: 33-39.
- [18] Duwairi HM, Abdullah M (2008) Numerical computation of fluid flow in a magnetohydrodynamic micropump. Turkish J Eng Env Sci (32): 1-5.
- [19] Abdullah M, Duwairi HM (2008) Thermal and flow analysis of two-dimensional fully developed flow in an AC magneto-hydrodynamic micropump. Microsyst Technol 14: 1117-1123.